

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公開番号】特開2003-162051(P2003-162051A)

【公開日】平成15年6月6日(2003.6.6)

【出願番号】特願2001-360938(P2001-360938)

【国際特許分類第7版】

G 0 3 F 7/004

【F I】

G 0 3 F 7/004 5 0 3 A

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月25日(2004.5.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 電子線又はX線の照射により酸を発生する化合物を含有する電子線又はX線レジスト組成物において、

該電子線又はX線の照射により酸を発生する化合物(a)が、スルホニウムスルホン酸塩及びヨードニウムスルホン酸塩の群から選択されるオニウムスルホン酸塩を少なくとも2種含有することを特徴とする電子線又はX線レジスト組成物。

【請求項2】

請求項1に記載の電子線又はX線レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。